

2Т825А - 2Т825В

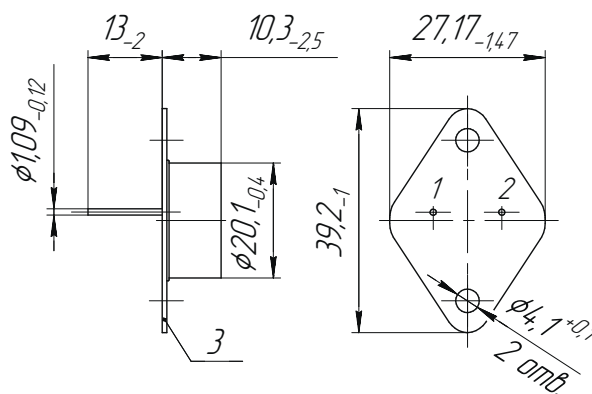
аА0.339.054 ТУ

аналоги 2N6287
2N6286
2N6285

Меца - планарные составные транзисторы



Ключевые и линейные схемы аппаратуры специального назначения.
T_{экспл.}: - 60°C ... +125°C



- 1 — база
- 2 — эмиттер
- 3 — коллектор

Металлостеклянный корпус КТ-9 (ТО-3)

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при T _{окр. ср.} = +25°C)	Условное обозначение	Значение параметров					
			2Т825А		2Т825Б		2Т825В	
			не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В (I _к = 1 мА, U _{бэ} = 1,5 В)	U _{кэ max}	100	-	80	-	60	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер - база, В	U _{эб max}	5	-	5	-	5	-
3.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	I _{к max}	-	20	-	20	-	20
4.	Статический коэффициент передачи тока, (U _{кб} = 10 В, I _э = 10 А)	h _{21э}	500	18000	750	18000	750	18000
5.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (I _к = 10 А, I _б = 0,04 А)	U _{кэ нас}	-	2	-	2	-	2
6.	Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, (U _{кэ} = 3 В, I _к = 10 А, f _{изм} = 1 МГц)	h _{21э}	4	-	4	-	4	-
7.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при T _к = +25°C, Вт	P _{к max}	-	125	-	125	-	125

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

1. 1. 1. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ Р-Н-Р ТИПА